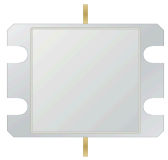
5300–5900 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 56.5 dBm (標準値)

LCT-5300-5900-PS56p5T · 5300–5900 MHz · GaN 内部整合型パワートランジスタ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 56.5 dBm (標準値); 電力利得 12.5 dB (標準値); PAE 45 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%.

CMW025B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

RF ポートに外付け DC ブロック・コンデンサが必要です。

パッケージ外形寸法: 24.2 × 17.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	5300	-	5900	MHz
飽和出力電力	-	56	56.5	-	dBm
電力利得	-	12	12.5	-	dB
電力付加効率	-	40	45	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	1.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン動作電圧	-	-	-	-	40	V
ゲート動作電圧	-	-	-	-	[-4, -2]	V
ピンチオフ電圧	-	-4	-	-2	VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA	V
ゲート逆方向電流	-	-	-	0.01	VDS = 0 V; VGS = -10 V	A

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	60	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	175	°C
最大入力電力	-	-	-	46	dBm

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	-	-	-	200	°C

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	24.2 × 17.4	mm
パッケージ外形寸法 (H)	-	mm

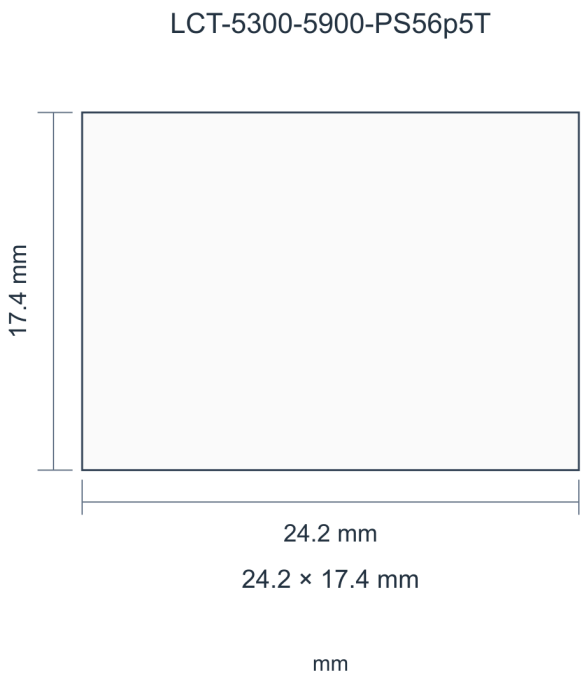
現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

CMW025B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 RF ポートに外付け DC ブロック・コンデンサが必要です。 G: RF入力 D: RF出力 S: ソース／グランド

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

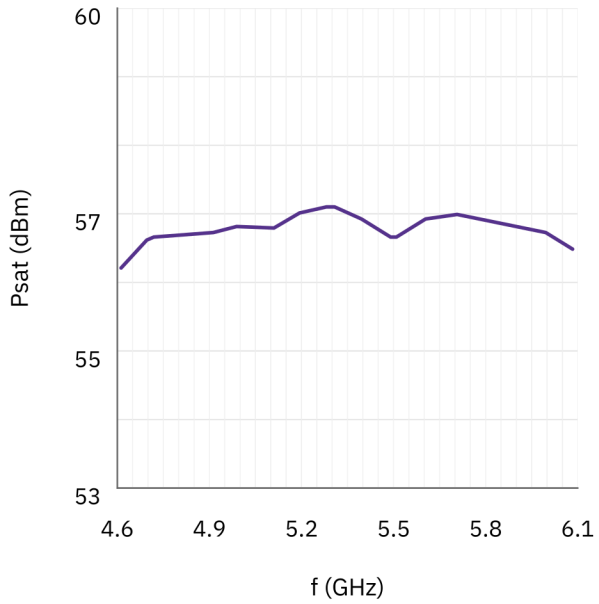


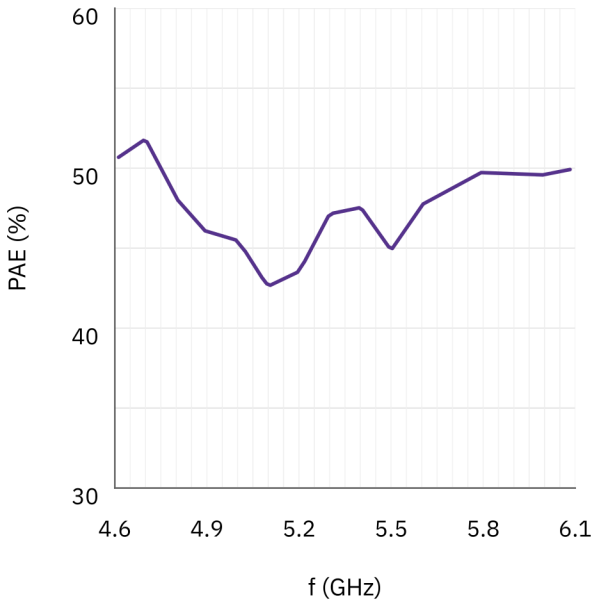
性能特性曲線

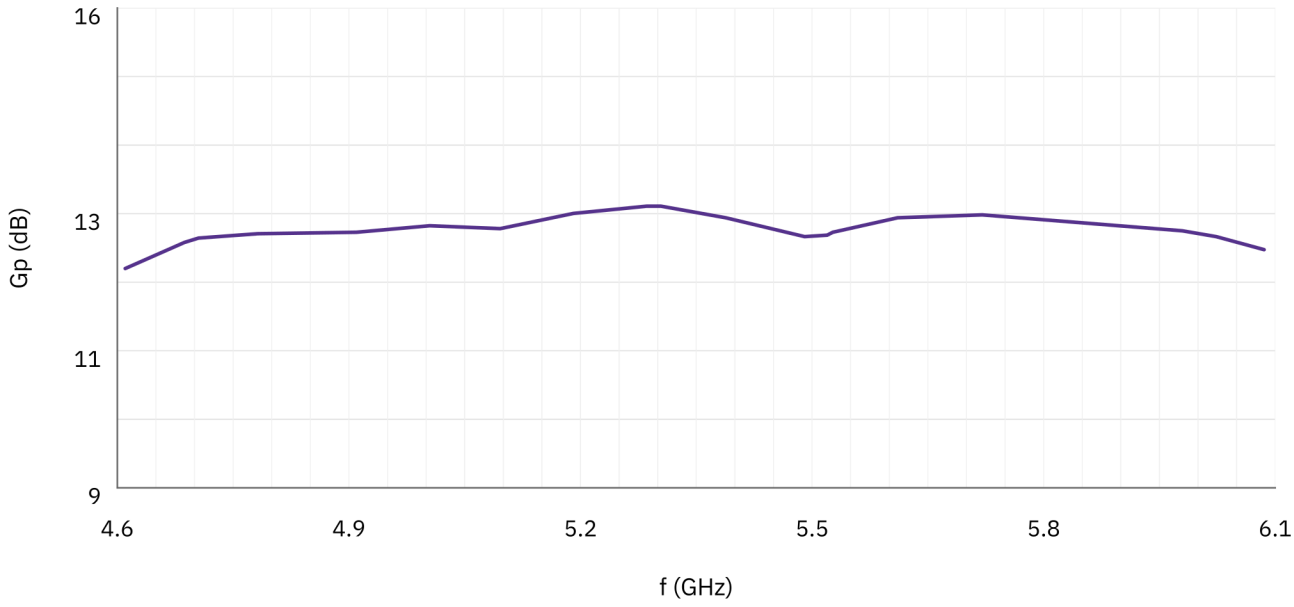
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

出力電力、電力付加効率、電力利得。

図の注記：Vd=+40V; Vg=-3.1V; Pin=44dBm。 読み取り値は近似値です。 デューティ比 = 1%。







文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。